

ЦМД могут образовываться при намагничивании плёнки во внешн. магн. поле (поле смещения, или поле подмагничивания) $H_{\text{см}}$, направленном вдоль ОЛН (рис. 1). Для того чтобы намагченность в объёме плёнки была направлена вдоль ОЛН, энергия магн. анизотропии должна

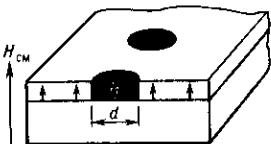


Рис. 1. Цилиндрические магнитные домены (ЦМД) в тонкой магнитной пленке с одноосной анизотропией ($H_{\text{см}}$ — магнитное поле смещения, d — диаметр ЦМД).

превышать магнитостатич. энергию (энергию магнитных полюсов, образующихся на поверхности плёнки, когда намагченность направлена перпендикулярно к этой поверхности).

Первые фотографии изолированных ЦМД были получены в США (1959), решётки ЦМД — в Чехословакии (1960). Для наблюдения ЦМД используют магнитооптические эффекты (Фарадея эффект, Керра эффект и др.); существуют также электронные методы регистрации ЦМД.

Основные свойства ЦМД. В исходном размагнченном состоянии (при $H=0$) плёнка из ЦМД-материала обладает, как правило, неупорядоченной лабиринтной доменной структурой (рис. 2, а) с двумя типами доменов, намагченность которых направлена вдоль либо против нормали к поверхности плёнки. Характерное значение ширины домена в лабиринтной структуре зависит от намагченности насыщения и составляет 0,5—5 мкм в ферритах-гранатах, 0,1—0,5 мкм в гексаферритах, 30—100 мкм в ортоферритах.

При увеличении напряжённости поля смещения (напр., направленного вверх, как показано на рис. 1) лабиринтная доменная структура превращается в структуру ЦМД; домены с намагченностью, ориентированной по полю, стремясь уменьшить энергию образца, увеличиваются в объёме, а домены с противоположным направлением намагченности сжимаются по ширине и уменьшаются по длине до тех пор, пока не превратятся в изолированные ЦМД (рис. 2, б).

ЦМД поддерживается в устойчивом равновесии под действием трёх сил: сжимающей со стороны поля смещения;

растягивающей силы магнитостатич. происхождения; сжимающей силы поверхностного натяжения доменной стенки. Именно благодаря последней поддерживается круглая форма ЦМД.

Изолированные ЦМД существуют в определ. интервале значений напряжённости поля смещения $H_1 < H_{\text{см}} < H_2$ (рис. 3, слева). При $H=H_2$ происходит коллапс (схлопывание) ЦМД, при $H=H_1$ он растягивается в полоску. Критич. поле H_1 наз. полем эллиптич. неустойчивости, H_2 — полем коллапса. Значения этих полей зависят от соотношения между толщиной плёнки h и её характеристич. длиной l (рис. 3, справа). При изменении величины $H_{\text{см}}$ в интервале от H_1 до H_2 диаметр ЦМД изменяется примерно на $\pm 50\%$ относительно ср. значения, равного 81. Зависимость диаметра ЦМД от поля смещения практически линейная.

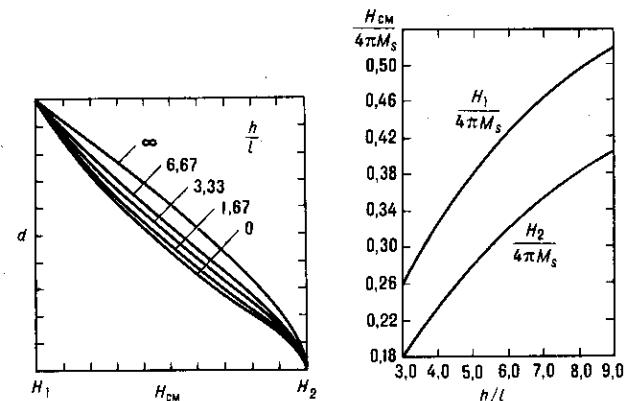


Рис. 3. Слева — зависимость диаметра ЦМД d от поля смещения $H_{\text{см}}$ в пленках различной толщины; справа — зависимость критических полей H_1 и H_2 от h/l .

В ряде экспериментов, однако, наблюдаются т. н. жёсткие ЦМД, для исчезновения которых необходимо приложить поле смещения, почти вдвое превышающее поле коллапса нормального ЦМД, причём конечный диаметр жёсткого ЦМД непосредственно перед коллапсом значительно меньше размера нормального ЦМД в том же материале. Исследования таких различий в поведении при коллапсе, а также в экспериментах по трансляции ЦМД в градиентном поле смещения привели к обнаружению внутр. структуры доменных стенок ЦМД, т. н. состояний ЦМД.

Состояния ЦМД. В пленках ЦМД-материалов, в отличие от случая неограниченной среды, доменные стенки являются скрученными, сильное размагничивающее поле ориентирует намагченность вблизи поверхностей пленки вдоль нормали к плоскости доменной стенки. Тогда в верх. и ниж. частях пленки стена имеет структуру Нееля (см. Нееля стена), и лишь в середине пленки доменная стенка имеет структуру Блоха (см. Блоха стена). Толщина доменной границы в типичных ЦМД-материалах изменяется в пределах 10—100 нм.

Состояние ЦМД определяется пространственной конфигурацией намагченности в центре его доменной стенки в сечении ЦМД плоскостью, проходящей через середину пленки, где доменная стенка является блоховской и намагченность лежит в плоскости пленки. На рис. 4 представлено несколько возможных простых структур стенок ЦМД.

Состояние ЦМД характеризуется т. н. индексом состояния

$$S = \oint \frac{d\phi}{2\pi},$$

где ϕ — угол между намагченностью и произвольным направлением в плоскости пленки. Т. о., S представляет

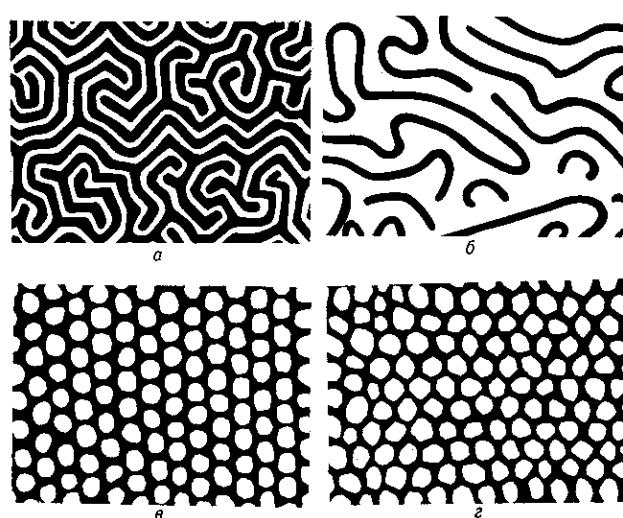


Рис. 2. Трансформация лабиринтной доменной структуры под действием внешнего поля: а — лабиринтная доменная структура; б — решётка ЦМД; в — сотовая доменная структура.